

## 진공중의 정전계

- $\epsilon_0$  (진공중의 유전율) =  $8.855 \times 10^{-12}$  [F/m]
- 쿨롱의 법칙
 
$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{Q^2}{r^2}$$
 [N]
- 전기장의 세기  $E$  [V/m = N/C] : 단위 정전하가 받는 힘
 
$$\mathbf{E} = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2} \mathbf{a}_r \rightarrow E = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2}$$
 [V/m = N/C]
- 전위 (전압) [J/C = V] :  $V = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2}$
- $F, E, V$  의 비교 :
 
$$F = QE = qE = eE = ma = mg = m \frac{v}{t}$$

$$V = Er = Ed$$
- 도체구의 성질
  1. 주입된 전하는 도체 표면에만 존재 (도체내부의 전기장  $E = 0$ , 전위  $V =$  일정하게 존재)
  2. 전기력선은 도체표면과 수직으로 발산, 흡입된다 (전기력선과 수직인면 = 등전위면  $\rightarrow V$  값은 항상 일정)
  3. 도체 표면의 전기력선 밀도 = 전기장의 세기
  4. 주입된 전하는 곡률이 큰 (곡률 반경이 작은) 곳에 집중.
- 포와송 방정식 :  $\nabla^2 \cdot V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$
- 라플라스 방정식 (자유공간  $\rho = 0$ ) :  $\nabla^2 \cdot V = 0$
- 전기력선 방정식 :  $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$
- 전기계 계산식  $\mathbf{E}$  [V/m]
  1. 전하  $Q$  가 주어질때 :  $\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r \rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
  2.  $V$  와  $R$  이 주어진 경우 :  $E = \frac{V}{r} = \frac{V}{l}$
  3. 선 전하 밀도가 주어진 경우 :  $\mathbf{E} = \frac{\rho L}{2\pi\epsilon_0 \rho} \mathbf{a}_\rho$
  4. 면 전하 밀도가 주어진 경우
    - 무한평판 :  $\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_x$
    - 두개평판 또는 (구)도체 :  $\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \mathbf{a}_x$
  5. 가상구 :  $E = \frac{Q \cdot r}{4\pi\epsilon_0 a^3} \propto r$
  6. 전위경도 :  $\mathbf{E} = -\nabla V$   
(전기장과 전위경도는 크기는 같고 방향은 반대이다)
- 정전응력  $f_e$  [N/m<sup>2</sup>] = 에너지 밀도  $dW_E/dv =$  [J/m<sup>3</sup>]
 
$$\Rightarrow \text{도체 표면에 작용하는 힘}$$

$$f_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{D^2}{2\epsilon_0}$$

- 전기 쌍극자 모멘트 :  $\mathbf{p} = Q\mathbf{d}$  [C·m]
 
$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$
 [V]  $\theta = 0^\circ$  일때  $V$  최대
 
$$E = \frac{V}{r} \propto \frac{1}{r^3} \rightarrow r^3 \text{에 반비례}$$

## 진공중의 도체계

- 전위계수  $P_{rr} = P_{sr}$  ( $s$  도체는  $r$  도체 내부에 존재)
 
$$V_i = \sum_j P_{ij} Q_j, Q_i = \sum_j q_{ij} V_j$$
- 용량계수, 유도계수
 
$$q_{rr} > 0 \Rightarrow \text{용량계수}, q_{sr} \leq 0 \Rightarrow \text{유도계수}$$
- 정전용량  $C$  [F] 계산식
  1. 동심구 :  $Q = CV$  [C],  $C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$  [F]
  2. 반경  $a$  [m] 인 도체구 :  $C = 4\pi\epsilon_0 a$  [F]
  3. 평행판 콘덴서 :  $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$  [F]
  4. 동심원통 :  $C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{b}{a}}$  [F],  $C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}}$  [F/m]
  5. 두 평행 도선간 :  $C = \frac{\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{d}{r}}$  [F],  $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{r}}$  [F/m]

## 유전체

- 유전율  $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$  [F/m] 전속밀도  $D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \epsilon E$  [C/m<sup>2</sup>]
- 분극  $P$  [C/m<sup>2</sup>]  $\Rightarrow$  유전체 내의 전속밀도
 
$$P = \chi_e E = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E = \epsilon_0 \epsilon_r E - \epsilon_0 E = \epsilon E - \epsilon_0 E$$

$$P = D - \epsilon_0 E = D - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r E}{\epsilon_r} = D - \frac{D}{\epsilon_r} = D \left( 1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$
- 경계조건 (p.152)
  1. 전기장  $E$  의 평행(접선) 성분은 같다.
 
$$E_1 \sin\theta_1 = E_2 \sin\theta_2$$
  2. 전속  $D$  의 수직(법선) 성분은 같다.
 
$$D_1 \cos\theta_1 = D_2 \cos\theta_2, \epsilon_1 E_1 \cos\theta_1 = \epsilon_2 E_2 \cos\theta_2$$
  3. 전속선은 유전율이 큰 쪽으로 집중된다.
 
$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}, \theta \propto \epsilon$$
  4. 힘은 유전율이 작은 쪽으로 작용한다.
 
$$\text{수평성분} = \frac{1}{2} \epsilon E^2, \text{수직성분} = \frac{D^2}{2\epsilon}$$

## 전류

- 옴의 법칙
 
$$\text{전류밀도 } i = \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = \frac{I}{S}$$
 [A/m<sup>2</sup>]
 
$$k = \sigma : \text{도전율 [S/m]}, \rho = \frac{1}{\sigma} : \text{비저항, 고유저항을 [}\Omega \cdot \text{m]}$$
- $RC = \rho \epsilon \Rightarrow R = \frac{\rho \epsilon}{C} \left[ \because R = \rho \frac{l}{S}, C = \frac{\epsilon S}{l} \right]$

## 전계와 자계의 비교

전계	자계
전하 : $Q[C]$	자극의 세기 $m[Wb]$
유전율 : $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r [F/m]$	투자율 : $\mu = \mu_0 \mu_r [H/m]$
전계 : $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ $E = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2} [V/m]$	자계 : $H = \frac{m}{4\pi\mu_0 r^2}$ $H = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m}{r^2} [AT/m]$
전위 : $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ $V = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r} [V]$	자위 : $V_m = \frac{m}{4\pi\mu_0 r} = U$ $V_m = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m}{r} [AT]$
전속밀도 : $D = \epsilon E = \epsilon_0 E + P [C/m^2]$	자속밀도 : $B = \mu H = \mu_0 (H + M)$ $[Wb/m^2]$
분극 : $P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E,$ $P = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) [C/m^2]$	자화의 세기 : $M = \mu_0 (\mu_r - 1) H = J,$ $M = B \left(1 - \frac{1}{\mu_r}\right) [Wb/m^2]$
정전응력 : $f_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ $f_e = \frac{1}{2} DE = \frac{D^2}{2\epsilon} [N/m^2]$	에너지밀도 : $f_m = \frac{1}{2} \mu H^2$ $f_m = \frac{1}{2} BH = \frac{B^2}{2\mu} [J/m^2]$

## 진공중의 정자계

### • 자계 계산식

1. 반경  $a[m]$  인 원형 코일 중심의 자계  $H = \frac{I}{2a} [AT/m]$

권수 (N) 이 주어진 경우  $H = \frac{NI}{2a} [AT/m]$

$z$  축 상에서의 자계  $H = \frac{I \cdot a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} [AT/m]$

2. 무한장 직선도체  $H = \frac{I}{2\pi r} [AT/m]$

3. 유한장 직선도체  $H = \frac{I}{4\pi r} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) [AT/m]$

4. 반경  $a[m]$  인 무한장 가상원통도체

(내부에 전류분포가 균일  $\rightarrow$  가정)

$$H = \frac{r \cdot I}{2\pi a^2} \propto r [AT/m]$$

5. 환상 솔레노이드 내부자계  $H = \frac{N \cdot I}{2\pi r} [AT/m]$

6. 무한장 직선 솔레노이드 내부자계  $H = n_0 \cdot I$

where  $n_0 = 1m$  당 권수

(솔레노이드 내부  $\Rightarrow$  평등자장, 외부  $H = 0$ )

7. 정  $n$  변형 중심자계 :  $H = \frac{nI \tan \frac{\pi}{n}}{2a}$

## 자기회로, 전자유도, 인덕턴스

### • 히스테리시스 곡선 (B - H) 곡선

종축 (자속밀도) : 잔류자기, 횡축 (자계) : 보자력

영구자석  $\Leftrightarrow$  연철

특징 : 보자력이 우수, 잔류자기 우수

$\Rightarrow$  히스테리시스 곡선의 면적이 크다

• 자기저항(리럭턴스) :  $\mathfrak{R} = R_m = \frac{l}{\mu S}$

• 공극이 있는 경우 자기저항 :  $\mathfrak{R}_1 = \frac{l}{\mu S} + \frac{l_0}{\mu_0 S} = \frac{l + \mu_r l_0}{\mu S}$

• 공극이 없는 경우에 대한 있는 경우  $\mathfrak{R}$  의 비교

$$\frac{\mathfrak{R}_1}{\mathfrak{R}} = \frac{\frac{l + \mu_r l_0}{\mu S}}{\frac{l}{\mu S}} = \frac{l + \mu_r l_0}{l} = 1 + \frac{\mu l_0}{\mu_0 l}$$

• 페러데이 법칙 :  $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$

(-) : 렌츠의 법칙, N : 노이만의 법칙

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N^2}{\mathfrak{R}} = \frac{\mu S N^2}{l} \propto N^2$$

• 상호 인덕턴스  $M = k \sqrt{L_1 L_2} \rightarrow k$  : 결합계수

$$M = \frac{N_2}{N_1} L_1, \frac{N_1}{N_2} L_2, M = \frac{\mu S N_1 N_2}{l}$$

- 가동 접속 (같은 방향)  $L = L_1 + L_2 + 2M$

- 차동 접속 (다른 방향)  $L = L_1 + L_2 - 2M$

## 전자장 (전계와 자계가 90 방향 공존)

• 변위전류  $I_d$  = 유전체 내에 흐르는 전류로 자기발생

- 변위전류 밀도  $\mathbf{J}_d [A/m^2] = \frac{I_d}{S} [A/m^2]$

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\epsilon}{d} \cdot \frac{\partial V}{\partial t}$$

- 변위전류 최대값  $I_{d,max} = \omega C V_m$

### • 전자파

1. 특성 (고유, 파동) 임피던스 :

$$Z_0 = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = 377 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$$

2. 속도 :  $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} [m/sec]$

3. 파장 :  $\lambda = \frac{v}{f}$

• 포인팅 벡터 : 순시 전력밀도 (p.428)

$$\mathbf{S} = \frac{P}{S} = E H \sin \theta = \mathbf{E} \times \mathbf{H} [W/m^2]$$

• 맥스웰 방정식

1.  $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v [C/m^3] \Rightarrow$  가우스 법칙

2.  $\nabla \cdot \mathbf{B} = \text{div} \mathbf{B} = 0 \Rightarrow$  독립된 자극은 존재하지 않음 (자속의 연속성)

3.  $\nabla \times \mathbf{E} = \text{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \Rightarrow$  페러데이 법칙

4.  $\nabla \times \mathbf{H} = \text{rot} \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

암페어 주회 적분의 법칙

(전류와 자장의 관계를 가장 잘 나타냄)